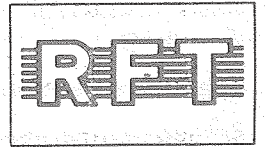


Information



SU 186 L

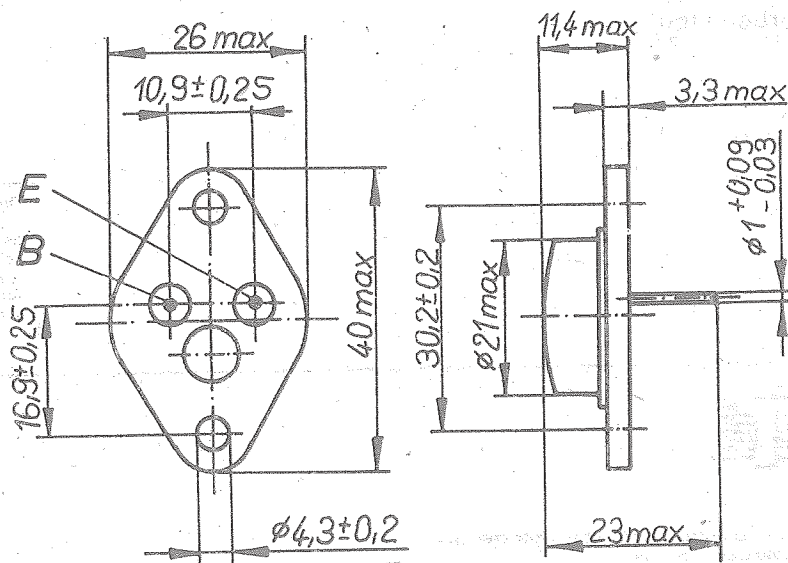
2/86

vorläufige technische Daten

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Liebknecht“ Stahnsdorf

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Schaltnetzteile an niedrigen Versorgungsspannungen

Maße in mm und Anschlußbelegung
Kollektor am Gehäuse
Masse etwa 22 g



Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung $I_E = 0$	U_{CBO}	160 V
Kollektor-Emitter-Spannung $I_B = 0$	U_{CEO}	125 V
Kollektorstrom	I_C	20 A
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}	25 A
Basisspitzenstrom	I_{BM}	9,0 A
Gesamtverlustleistung $t_c = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	150 W
Sperrschichttemperatur	t_j	200 °C
Betriebstemperatur	t_a	125 °C

Kennwerte ($t_c = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$)

		min.	max.
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{CE} = 160\text{ V}, U_{BE} = -2\text{ V}$	I_{CEX}		1,0 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung $I_C = 100\text{ mA}$	$U_{(BR)CEO}$	125 V	
Emitter-Basis-Durchbruchspannung $I_E = 10\text{ mA}$	$U_{(BR)EBO}$	7,0 V	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 15\text{ A}, I_B = 1,5\text{ A}$	U_{CEsat}		1,5 V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 15\text{ A}, I_B = 1,5\text{ A}$	U_{BEsat}		2,0 V
Abfallzeit des Kollektorstromes $I_C = 15\text{ A}, I_B = 1,5\text{ A}, I_B = 3,0\text{ A}$	t_f		0,7 μs

Änderungen vorbehalten!

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.



Herausgeber

vab applikationszentrum elektronik berlin
im vab kombinat mikroelektronik

Mainzer Straße 25

Berlin 1035

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055